ショートノート・

マイクロコントローラを利用した金ナノ粒子誘電泳動 の自動停止機構

島田

宏†

浦江 哲也†

水柿 義直^{†a)}(正員)

Microcontroller-Based Automatic Shut-Off System for Dielectrophoretic Assembly of Gold Nanoparticle Arrays

Tetsuya URAE[†], Hiroshi SHIMADA[†], Nonmembers, and Yoshinao MIZUGAKI^{†a)}, Member

* 電気通信大学大学院情報理工学研究科,調布市

Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications (UEC Tokyo), 1–5–1 Chofugaoka, Chofu-shi, 182–8585 Japan a) E-mail: y.mizugaki@uec.ac.jp

DOI:10.14923/transelej.2022JCF6001

あらまし 誘電泳動法により微小電極ギャップ内に 金ナノ粒子配列を形成することで単一電子素子を実現 できるが,形成に要する時間は一定ではない.我々は, 金ナノ粒子配列形成に伴う電極間インピーダンスの減 少を検知して誘電泳動電圧印加を停止する誘電泳動自 動停止システムを構築した.

キーワード インピーダンス測定, 電界整列, 金コ ロイド溶液, 単一電子帯電効果

1. まえがき

Schönenberger らの報告[1]以降,金ナノ粒子を鳥電 極とする単一電子素子が数多く研究されてきた.微小 電極ギャップ内に金ナノ粒子配列を形成する方法の一 つに,誘電泳動法がある[2]~[9].我々は誘電泳動法 による金ナノ粒子配列形成に取り組んできたが[10], 形成過程には確率的な側面があり,誘電泳動に使用す る交流印加電圧の周波数,振幅,印加時間を固定して も,同一の結果は得られない[11].特に,金ナノ粒子 配列形成に適切な誘電泳動時間は大きくばらつき,金 ナノ粒子の集合が見られない事態や,逆に長すぎて過 電流破壊が発生する事態にしばしば遭遇する.

電極間に金ナノ粒子配列が形成されると、それが新 たな電流経路となり、電極間のインピーダンスが低下 する.よって、誘電泳動中の電極間インピーダンスの 大きさ(以下 |Z|)をモニターすることにより、金ナ ノ粒子配列形成状況の把握、更には形成工程の制御に 用いることができる.本研究では、誘電泳動実施中の |Z|をリアルタイムでモニターするとともに、|Z|が設 定基準(Z_{stop})未満に低下した際に電圧印加を停止す る誘電泳動自動停止システムを構築した.

2. 誘電泳動自動停止システムの構成

自作制御ユニット, 誘電泳動の交流電源となるファン クションジェネレータ(FG), 及びプログラミング/表示 用 PC からなる誘電泳動自動停止システムの構成を図 1 に示す. 自作制御ユニットには, オペアンプ回路から なるアナログ回路とマイクロコントローラ(マイコン) を主体としたデジタル回路が含まれる. マイコンには Microchip Technology 社製 dsPIC33EP256GP502 [12] を用いた. 電極ギャップ間にかかる交流電圧 V とグ ラウンドに流れる交流電流 I を, 全波整流及び平滑し て直流化し, マイコン内蔵の AD 変換器 (10-bit, 1.1 Msps) で読み取ったのち, それらの値をマイコンにて 除算して |Z| を求める. また, マイコンから FG に対 して振幅変調 (AM) 信号を送り, FG の出力振幅を制 御する. なお, FG 出力の周波数と最大出力振幅は手 動で設定する.

動作フローの概略を図 2 に示す. FG 出力振幅の制 御 (停止判定) は次の 3 通りとした. (i) 誘電泳動開始 前の電極間 |Z| を FG 出力 amp_1 % にて計測し, その 値が Z_{shrt} 未満であった場合は電極間が短絡している とみなし, FG 出力を停止する (AM 信号を 0% にす る). (ii) 電極間 |Z| が Z_{shrt} を上回った場合は, FG 出 力を 100% として |Z| を計測する. これを初期値 Z_{init} として, 誘電泳動を継続する. 誘電泳動中の |Z| が $(1-\delta)Z_{init}(=Z_{stop})$ を下回った場合, 電極間に金ナノ 粒子配列が形成されたとみなし, FG 出力を停止する. ここで $\delta(>0)$ は判定基準とする減少率である. (iii) 誘 電泳動開始から t_{end} の時間が経過した場合は, そのま までは金ナノ粒子配列が形成できないとみなし, FG 出力を停止する.

|Z|の算出及び停止判定は、速度を優先するため割 り込み処理で行うようにプログラムした.あわせて、 Vと1の値を複数回取得後に平均化してから|Z|を算



図1 誘電泳動自動停止システムの構成

Fig. 1 Configuration of the dielectrophoresis (DEP) automatic stop system for assembling gold nanoparticles (GNPs).



図 2 誘電泳動自動停止システムの動作フローの概略 Fig. 2 Simplified operation flow of the DEP automatic stop system.

出する機能を付加した.割り込み処理のデータはマイ コン内のバッファに格納し,自動停止後にバッファ内 のデータを PC に送信することにした.更に,割り込 み処理が行われていないタイミングにおいて,その時 点での最新のデータのみを PC に送信し, PC にリアル タイム表示するようにした.

3. 自作制御ユニットでの |Z| 計測間隔の評価

誘電泳動自動停止システムでは、自作制御ユニット での |Z| 計測の時間間隔が重要な性能評価指標の一つ となる. 誘電泳動でのナノ粒子配列形成時間として、 10 μ m 幅の電極間ギャップを直径 150 nm の金ナノ粒 子配列で架橋するのに 4 ms を要したとの報告 [13] が あり、|Z| 計測間隔は 1 ms を十分下回る必要があると いえる. そこで、実際の試料の代わりに 20 k Ω の抵抗 器を接続し、平均化測定回数を 1 回から 128 回まで 変化させて、|Z|の計測値と計測間隔を調べた. なお、 バッファのサイズは 2000 点とし、FG の最大出力振幅 と周波数をそれぞれ 5.5 Vpp と 100 kHz に設定した.

図3に各平均化測定回数に対する |Z|の計測値(エ ラーバーは標準偏差 σ)と計測間隔を示す.平均化測 定回数を増やすと |Z|の標準偏差 σ が小さくなる一方, 計測間隔は長くなる.そこで両者のバランスをとって 16回平均を採用することとした.このときの計測間 隔は 32.5 μ s であり,目安とした1 msを大きく下回っ ている.また,標準偏差 σ は 0.15% であることから, 誘電泳動停止基準とする減少率 δ は ±3 σ の幅である



- 図 3 自作制御ユニットでの平均回数と |Z| 計測値及び計 測間隔. 試料の代わりに 20 kΩの抵抗体を用いた.
- Fig. 3 Measurement results of |Z| values and intervals of acquisitions. A 20 k Ω resistor was used in place of a nanogap sample.

0.9%以上に設定すれば計測のばらつきの影響をほぼ 排除できる。

誘電泳動自動停止システムを利用した金ナノ粒 子配列形成

誘電泳動自動停止システムを利用して金ナノ粒子 配列形成を試みた.実験では、まず酸化膜付きシリコ ン基板上に、電子線描画と斜め真空蒸着によって、幅 200 nm 程度のギャップをもつ 2 端子のニクロム/金電 極を作製した.1度目と 2 度目の真空蒸着のニクロム/ 金の膜厚は、それぞれ 5/20 nm と 5/45 nm とした(ち なみに、乾燥状態での電極間の |Z| は 100 kHz にて 約 100 kΩ である). 続いて 5 mM デカンジチオール (1,10-decanedithiol) 溶液に 18 時間液浸して金電極表 面をジチオールで修飾した.その後、粒径 30 nm の金 ナノ粒子のコロイド溶液 (クエン酸溶媒)を滴下し、誘 電泳動自動停止システムを用いて金ナノ粒子の誘電泳 動を行った.誘電泳動終了後は、直ちに試料を超純水 に 30 s 浸した後、更に新たな超純水に 1 min 浸して金 コロイド溶液を除去し、窒素ガンで乾燥させた.

図 4 は FG の周波数と最大出力振幅を 100 kHz と 5.5 V_{pp} に設定し、 $\delta = 3\%$ で誘電泳動を行ったときの 自動停止直前のインピーダンスの変化の様子である. 自動停止直前にて |Z| は小さな増減を繰り返し、 Z_{stop} を下回ったところで自動停止した.

図5は電極間ギャップ近傍の走査電子顕微鏡写真で あり、電極間に金ナノ粒子配列が形成されていること が分かる.また、この金ナノ粒子配列の室温での抵抗 値は3.1 GQ であった.これは、我々の過去の研究に おいて経験的に得た「単一電子帯電効果が発現する抵 抗値の範囲 (10 kQ 以上、28 GQ 以下)」[11] に収まっ ている.



- 図4 金ナノ粒子の誘電泳動を実施した際の自動停止直前 の |Z| の変化の様子. δ は 3% に設定した.
- Fig. 4 Impedance transition acquired by the DEP automatic stop system. δ was set at 3%.



図5 電極ギャップ付近の走査電子顕微鏡像 a 5 SEM image of GNPs assembled around the gap betw

Fig. 5 SEM image of GNPs assembled around the gap between two electrodes.

なお、この実験では、 amp_1 %、 Z_{shrt} , t_{end} をそれぞ れ 25%、7 kΩ、90 s に固定した. これらは、金ナノ粒 子配列形成には不十分と思われる電圧振幅、コロイド 溶液滴下直後の典型的な |Z| が 100 kHz にて約 10 kΩ であること(図4参照)に基づいた短絡判定値、過去 の研究における金ナノ粒子配列形成時間の最大値(約 70 s)の3割増しの時間、として決めたものであるが、 最適化されたものではなく、誘電泳動そのものの条件 とあわせて、より適切な値を調査していく必要がある.

5. むすび

本研究では、誘電泳動時のインピーダンスの変化に 着目して、マイコンを用いた誘電泳動自動停止シス テムを開発した. 16回平均時の |Z| 計測時間間隔は 32.5 μ s, 20 k Ω 抵抗体の |Z| 計測値のばらつきは標準 偏差で 0.15% であった. $\delta = 3\%$ に設定した誘電泳動 自動停止システムを用いて 30 nm 径の金ナノ粒子を 200 nm 程度の電極間ギャップに誘電泳動したところ、 |Z| が Z_{stop} を下回ったとき自動停止した. 走査電子顕 微鏡像により金ナノ粒子配列形成が確認された. 本シ ステムは、誘電泳動工程の評価及び制御に有効なツー ルとなることが期待できる.

謝辞 電気通信大学の関係者,特に瀬賀直功氏と守 屋雅隆博士の協力に感謝する.本研究の一部は JSPS 科研費 JP20H02201 の助成のもと行われた.

献

Ϋ́

- C. Schönenberger, H. van Houten, and H.C. Donkersloot, "Singleelectron tunnelling observed at room temperature by scanningtunnelling microscopy," Europhys. Lett., vol.20, no.3, pp.249–254, Oct. 1992. DOI: 10.1209/0295-5075/20/3/010
- [2] I. Amlani, A.M. Rawlett, L.A. Nagahara, and R.K. Tsui, "An approach to transport measurements of electronic molecules," Appl. Phys. Lett., vol.80, no.15, pp.2761–2763, April 2002. DOI: 10.1063/1.1469655
- [3] L. Zheng, S. Li, J.P. Brody, and P.J. Burke, "Manipulating nanoparticles in solution with electrically contacted nanotubes using dielectrophoresis," Langmuir, vol.20, no.20, pp 8612–8619, Sept. 2004. DOI: 10.1021/la049687h
- [4] S.O. Lumsdon and D.M. Scott, "Assembly of colloidal particles into microwires using an alternating electric field," Langmuir, vol.21, no.11, pp.4874–4880, May 2005. DOI: 10.1021/la0472697
- [5] R.J. Barsotti Jr., M.D. Vahey, R. Wartena, Y. Chiang, J. Voldman, and F. Stellacci, "Assembly of metal nanoparticles into nanogaps," small, vol.3, no.3, pp.488–499, March 2007. DOI: 10.1002/smll. 200600334
- [6] S. Kumar, Y.-K. Seo, and G.-H. Kim, "Manipulation and trapping of semiconducting ZnO nanoparticles into nanogap electrodes by dielectrophoresis technique," Appl. Phys. Lett., vol.94, no.15, 153104, April 2009. DOI: 10.1063/1.3118588
- D. Cheon, S. Kumar, and G.-H. Kim, "Assembly of gold nanoparticles of different diameters between nanogap electrodes," Appl. Phys. Lett., vol.96, no.1, 013101, Jan. 2010. DOI: 10.1063/ 1.3280859
- [8] W. Liu, C. Wang, H. Ding, J. Shao, and Y. Ding, "AC electric field induced dielectrophoretic assembly behavior of gold nanoparticles in a wide frequency range," Appl. Surf. Sci., vol.370, pp.184–192, May 2016. DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.02.118
- [9] A. Barik, X. Chen, and S. Oh, "Ultralow-power electronic trapping of nanoparticles with sub-10 nm gold nanogap electrodes," Nano Lett., vol.16, no.10, pp.6317–6324, Oct. 2016. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02690
- [10] M. Moribayashi, T. Yagai, M. Moriya, H. Shimada, A. Hirano-Iwata, F. Hirose, and Y. Mizugaki, "Single-electron charging effects observed in arrays of gold nanoparticles formed by dielectrophoresis between SAM-coated electrodes," AIP Conf. Proc., vol.2067, 020019, Jan. 2019. DOI: 10.1063/1.5089452
- [11] Y. Mizugaki, M. Moribayashi, T. Yagai, M. Moriya, H. Shimada, A. Hirano-Iwata, and F. Hirose, "Dielectrophoretic assembly of gold nanoparticle arrays evaluated in terms of room-temperature resistance," IEICE Trans. Electron., vol.E103-C, no.2, pp.62–65, Feb. 2020. DOI: 10.1587/transele.2019ECS6011
- [12] https://www.microchip.com/en-us/product/ dsPIC33EP256GP502#, 参照 March 10, 2022.
- [13] T. Koshi, Y. Nakajima, and E. Iwase, "Voltage and current conditions for nanoparticle chain formation using dielectrophoresis," Micro & Nano Lett., vol.12, no.8, pp.532–535, Aug. 2017. DOI: 10.1049/mnl.2017.0125

(2022 年 3 月 18 日受付, 5 月 23 日再受付, 6 月 9 日早期公開)